大阪・技術職求人・デバイス開発エンジニア（GaNパワー半導体）・半導体デバイス開発関連経験者歓迎

技術ポジション　大手企業　雰囲気友好　女性歓迎　社保完備　交通費支給　土日祝休み

募集職種

採用企業名
株式会社iSoftStone Japan

求人ID
1557581

部署名
技術

業種
電気・電子・半導体

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業

外国人の割合
外国人 半数

雇用形態
契約

勤務地
大阪府

給与
500万円 ~ 800万円

勤務時間
平日9：00ー18：00 (休憩時間　60分)

休日・休暇
年間休日 120日以上　有給休暇 初年度 10日(6か月目 ~)　完全週休二日制 土 日 祝日 年末年始

更新日
2026年11月11日 08:00

応募必要条件

職務経験
1年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
ビジネス会話レベル

日本語レベル
ビジネス会話レベル

その他言語
中国語： 北京語 - ビジネス会話レベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【業務内容】

窒化ガリウム（GaN）をはじめとする次世代パワー半導体デバイス、およびインダクタ・コンデンサなどの受動素子に関する研究開発、デバイス設計、プロセス集積技術の開発をご担当いただきます。

主な業務内容

1. GaNを中心とした次世代統合電源デバイスのコンセプト設計、シミュレーションを活用したデバイス設計および性能最適化
2. GaNデバイス、インダクタ、コンデンサなどのプロセス集積技術の開発および改善
3. 新規デバイスの研究開発計画の策定、試作、評価および開発プロジェクトの推進
4. 開発デバイスのデータ解析、不良・故障解析、信頼性評価および品質・性能改善
5. パワー半導体および垂直給電（Vertical Power Delivery）技術に関する市場・技術動向の調査
6. 技術調査や研究成果に基づく新規開発テーマの提案および技術的課題の解決

【福利厚生/休暇】

- 完全週休2日制（土日祝）
- 年末年始休暇
- 年間120日以上休日
- 有給休暇、育児休暇など
- 交通費支給（3万円以下）
- 社会保険、年金、雇用保険加入

スキル・資格

【応募資格（必須条件）】

- 半導体、電気・電子工学、マイクロエレクトロニクスなどの関連分野を専攻し、学士号以上の学位をお持ちの方
- パワー半導体市場や関連技術の動向について、情報収集・分析・整理を行う能力をお持ちの方
- 創造性、主体性、柔軟性を備え、新しい技術の習得や課題解決に積極的に取り組める方
- 社内外の関係者と円滑に連携できるコミュニケーション能力およびチームワークをお持ちの方
- 高い職業倫理観と責任感を持って研究開発業務に取り組める方
- 海外出張に対応可能な方
- **中国語：ビジネスレベル以上（流暢にコミュニケーションができる方）**
- **日本語：ビジネスレベル**

【歓迎条件】

- パワー半導体デバイスの動作原理、電気特性、評価技術に関する2年以上の研究開発経験
- GaN、SiCなどの次世代パワー半導体デバイスに関する設計・開発経験
- パワーデバイスの信頼性評価、故障解析および信頼性改善に関する専門知識・実務経験
- EDAツールを用いた半導体デバイスの設計・シミュレーション経験
- GaNデバイスや受動素子のプロセス集積、統合電源デバイスの開発経験
- 垂直給電技術や高効率電源デバイスに関する研究開発経験

【本ポジションの魅力】

- **先端技術への挑戦：** GaNパワー半導体や次世代統合電源デバイスなど、成長が期待される先端技術の研究開発に携われます。
- **幅広い技術領域：** デバイス設計からプロセス集積、シミュレーション、信頼性評価まで、一連の研究開発業務に関

わることができます。

- **グローバルな研究開発環境：** 国内外のエンジニアや研究開発チームと連携しながら、専門性を高められる環境です。
- **ワークライフバランス：** 土日祝日休みの勤務体系です。

会社説明